2　ウエハーの基板温度を四〇度超五〇〇度未満に維持しながら、酸素又はオゾンを用いたプラズマにより表面処理を行う工程
3　ウエハーの基板温度を一〇〇度超五〇〇度未満に維持しながら、タングステンの層を成膜する工程
(五)　特定半導体製造装置のうち、次に掲げる全ての工程により金属のコンタクト層を成膜するように設計したもの(二)に該当するものを除く。)
1　リモートプラズマ源及びイオンフィルターを用いて表面処理を行う工程
2　有機金属化合物を用いて銅の上に選択的にコバルトの層を成膜する工程
(六)　仕事関数金属(トランジスタの閾値電圧を制御するための材料をいう。以下同じ。)の原子層堆積装置であって、次の全てに該当するもの
1　次の全てに該当するもの
一　二以上の金属の供給源を有するもののうち、アルミニウムの前駆体用に設計した供給源を一以上有するもの
二　四五度超の温度で作動するように設計した前駆体容器を有するもの
2　仕事関数金属を成膜するよう設計した装置であって、次の全てに該当するもの
一　炭化チタンアルミニウムを成膜するもの
二　四・〇電子ボルト超の仕事関数を可能とするもの
(七)　特定半導体製造装置のうち、次に掲げる全ての工程により金属のコンタクト層を成膜するように設計したもの(二)に該当するものを除く。)
1　ウエハーの基板温度を二〇度超五〇〇度未満に維持しながら、有機金属化合物を用いて窒化チタン又は炭化タングステンの層を成膜する工程
2　ウエハーの基板温度を五〇〇度未満に維持しながら、〇・一三三パスカル超一三・三三パスカル未満の圧力でスパッタリング法によりコバルトの層を成膜する工程
3　ウエハーの基板温度を二〇度超五〇〇度未満に維持しながら、一三三・三パスカル超一三・三三キロパスカル未満の圧力で有機金属化合物を用いてコバルトの層を成膜する工程
(八)　特定半導体製造装置のうち、次に掲げる全ての工程により銅配線を形成するように設計したもの(二)に該当するものを除く。)
1　ウエハーの基板温度を二〇度超五〇〇度未満に維持しながら、一三三・三パスカル超一三・三三キロパスカル未満の圧力で有機金属化合物を用いてコバルト又はルテニウムの層を成膜する工程
2　ウエハーの基板温度を五〇〇度未満に維持しながら、〇・一三三パスカル超一三・三三パスカル未満の圧力で物理的気相成長法を用いて銅の層を成膜する工程
(九)　有機金属化合物を用いてバリヤー膜又はライナーを選択的に成膜するように設計した原子層堆積装置
(十)　ウエハーの基板温度を五〇〇度未満に維持しながら、絶縁膜と絶縁膜との隙間(幅に対する深さの比